

GVC-2000TD 高真空磁控离子溅射仪



- 可制备各种金属、单质、无机非金属薄膜
- 不破真空情况下，可实现多层复合膜制备
- 一键操作，全自动控制，智能化程度高
- 一致性、重复性好
- 内置多重靶材工作参数，无需摸索镀膜工艺
- 体积小，结构紧凑，非常节约空间

主要参数

| | | | |
|-----------|--|-------|-----------------|
| 外形尺寸 (主机) | 424(L)×345(D)×420(H) | 输入电源 | 220V/50Hz 1000W |
| 溅射靶头 1 | 直流磁控溅射 | 可用靶材 | 金属靶材 |
| 溅射靶头 2 | 射频磁控溅射 | 可用靶材 | 无机非金属靶材 |
| 真空系统 | 涡轮分子泵+旋片式真空泵 | 抽速 | 90L/s + 1.1L/s |
| 真空测量 | 复合式真空规 | 量程范围 | 1E-3 ~ 1E5Pa |
| 真空室 | φ 200×130mm 高硼硅玻璃 | 抽气节拍 | 10 分钟 (≤5E-3Pa) |
| 样品台尺寸 | φ 90mm | 样品台切换 | 自动控制 |
| 溅射靶材尺寸 | φ 57mm (厚度 0.1-2mm) | 工作真空 | 0.1-2Pa |
| 操作界面 | 7 英寸 TFT 触摸式液晶屏 | 操作语言 | 中文 (可选其它语言) |
| 冷水机 | 小型台式制冷机 | 冷水机功率 | 180W |
| 预溅射挡板 | 标配全自动控制预溅射挡板 | | |
| 膜厚仪 (选配) | 可实时显示镀膜厚度，并通过设定来控制镀膜过程，测量精度 0.01nm，设定精度 0.1nm，单次设定范围 1-999nm | | |
| 温控组件 (选配) | 样品台加热模块 300℃ /500℃ | | |
| 旋转组件 (选配) | 倾斜旋转、行星旋转等 | | |
| 小车 (选配) | 将主机、射频电源、冷水机等组装在一起，整体性好 | | |
| 安装环境 | 220V/10A 三孔插座一个、纯度 4N 及以上的高纯氩气 (出口压力 0.12MPa) | | |